

Contrôle Continu d'électromagnétisme- Durée : 1h30

Sans documents – calculatrice autorisée

I.- Champ magnétique produit par une puis deux spires

A) Soit une spire de rayon R et d'axe Oz parcourue par un courant d'intensité I (figure 1).

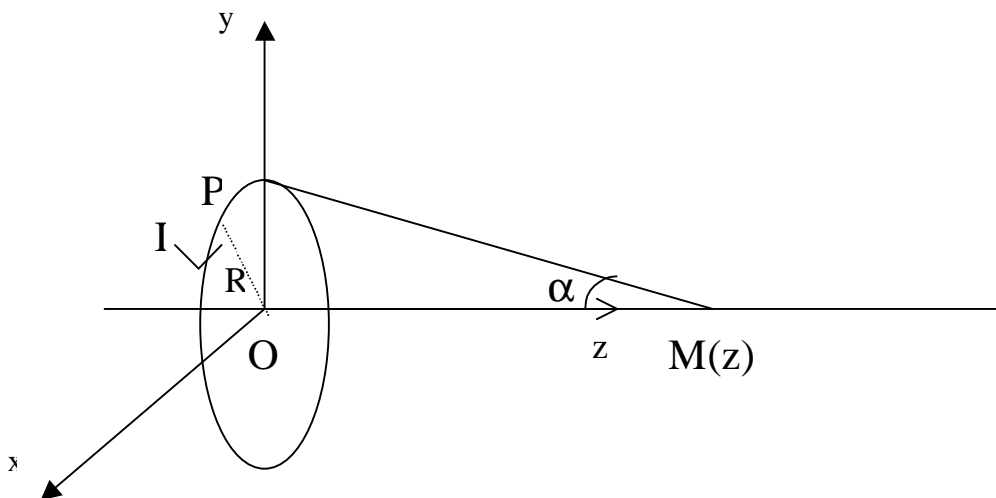
- 1) Etudier les symétries de cette distribution. En déduire la direction du champ magnétique $\mathbf{B}(M)$ en un point M quelconque de l'axe, à la distance z de l'origine.
- 2) $B(z)$ désigne la projection de $\mathbf{B}(M)$ sur la direction définie à la question 1). Quelle relation peut-on prévoir a priori entre $B(z)$ et $B(-z)$? Justifier.
- 3) On montre que la projection du champ magnétostatique créée par la spire au point M a pour expression :

$$B(z) = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{R^2}{R^2 + z^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Que vaut $B_0 = B(O)$ au centre de la spire ?

- 4) On se place en un point M' hors de l'axe de la spire. Quel système de coordonnées utiliserait-on pour étudier le champ $\mathbf{B}(M')$? Par des considérations de symétrie, indiquer comment se projetterait le champ $\mathbf{B}(M')$ sur la base correspondante. Préciser en le justifiant de quelles variables il dépendrait. **On ne demande pas d'effectuer le calcul.**

Figure 1

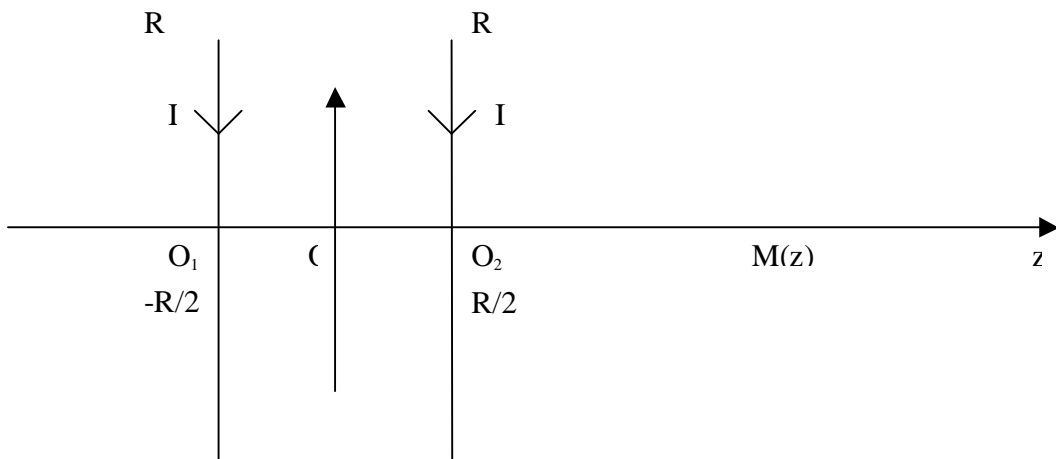


B) Deux bobines identiques à la précédente, de centres O_1 et O_2 et parcourues dans le même sens par un courant d'intensité I sont disposées sur le même axe Oz , O étant le milieu de O_1O_2 .

O_1O_2 a la valeur R (figure 2). On se place en un point M à l'intérieur des bobines ($-\frac{R}{2} \leq z \leq \frac{R}{2}$).

- 1) Exprimer l'intensité du champ \mathbf{B} au point M en fonction de $u = \frac{z}{R}$ et de B_0 (défini à la question A3).
- 2) Calculer \mathbf{B} en fonction de B_0 pour $u=0$ (origine) et $u=0.5$ ou -0.5 (centre des bobines). Que remarque-t-on ? Quel peut être l'intérêt de ce dispositif, aussi appelé bobines de Helmholtz ?

Figure 2



II.- Force de Lorentz et mesure du champ magnétique

On considère une plaquette parallélépipédique dont les dimensions sont : $L=10$ mm, $b=5$ mm, $h=10$ μm (figure 3).

La plaquette est parcourue par un courant continu d'intensité I uniforme réparti avec la densité volumique $\mathbf{j}=j \mathbf{e}_x$. Elle est placée dans un champ magnétique uniforme extérieur $\mathbf{B}=B \mathbf{e}_z$ avec $B>0$.

On néglige le champ magnétique créé par le courant I . On suppose qu'en présence du champ magnétique le vecteur densité de courant est toujours \mathbf{j} . On se place en régime permanent.

La plaque est constituée d'un semi-conducteur de type N, donc les porteurs de charges libres majoritaires sont des électrons. Ils sont animés de la vitesse \mathbf{v} , ont une masse m , une charge q et une densité volumique n (nombre de porteurs par unité de volume).

- 1) Exprimer la force magnétique \mathbf{F}_m à laquelle est soumis un électron de la plaquette de la part du champ \mathbf{B} .
- 2) Exprimer le vecteur vitesse \mathbf{v} des porteurs dans la plaquette en fonction de \mathbf{j} , n et q . En déduire une nouvelle expression pour la force magnétique en fonction de \mathbf{j} , n et \mathbf{B} .
- 3) Il y a accumulation des électrons sur la face A de la plaque; justifier. Il apparaît donc une différence de potentiel U et un champ électrique \mathbf{E} entre les faces A et A'.

Ecrire la force électrique \mathbf{F}_e à laquelle est soumis un électron de la part du champ \mathbf{E} .

Lorsqu'on est en régime permanent, il y a équilibre des forces électrique et magnétique. En déduire l'expression du champ électrique \mathbf{E} entre les faces de la plaquette dans ces conditions.

- 4) Calculer la différence de potentiel $U = V(A') - V(A)$ qui apparaît entre les faces A et A' en fonction de \mathbf{j} , b , n , q et du champ \mathbf{B} .
- 5) Ecrire l'expression du courant I dans la plaque en fonction de \mathbf{j} , b et h . En déduire que la différence de potentiel U peut se mettre sous la forme $U = \frac{kIB}{h}$ et exprimer la constante k en fonction de n et q . Justifier l'intérêt de ce dispositif dans la mesure des champs magnétiques.

- 6) La sensibilité du capteur étant définie par $s = \frac{U}{B}$, exprimer celle-ci en fonction de k , I et h .

A.N. : $k = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{C}^{-1}$; $I = 0,20 \text{ A}$. Calculer la sensibilité de ce capteur.

Pour un capteur donné, si on désire augmenter la sensibilité, sur quelle grandeur peut-on jouer et quel est l'inconvénient qui limite cette augmentation de la sensibilité ?

Figure 3

